

半 导 体 学 报

第 6 卷 第 1 期

1985 年 1 月

目 录

硅耗尽层少子产生率的强电场效应·····	李志坚	田立林	马鑫荣	(1)
离子注入 CO_2 激光退火硅中的深能级缺陷 ·····	鲍希茂	张新宇	柳承恩	(11)
硼注入 $\langle 100 \rangle$ 硅残余缺陷的沟道研究·····	邹世昌	倪如山	张祖华	(19)
二硫化钛电输运过程中的散射机制·····	陈 昕	何 青	王桢枢	周熙宁 (25)
在 $\text{GaAs-Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ 量子阱结构中的施主束缚能 ·····	刘振鹏	李天克		(32)
SiO_2 中电子束辐照产生的电子陷阱 ·····				
·····	朱文珍	常秀勤	李月霞	安贵仁 宁 华 (41)
凹源结构场效应晶体管·····				潘晓明 (49)
MoNb-GaAs 肖脱基势垒二极管的界面分析 ·····				
·····	俞鸣人	朱福荣	王 迅	王滨崎 邵 凯 卜积善 雷传仁 (55)
碲化铅/碲锡铅异质结构二极管结电阻的温度关系 ·····	张素英	乔怡敏		(61)
GaAs FETs 的小讯号微波网络参数的计算和分析·····	汪正孝			(67)
瞬态退火注砷硅亚稳态浓度的后热处理特性研究·····				
徐 立 钱佩信 侯东彦 林惠旺 李志坚 王豫生 阎建华 郑胜男				(76)

研 究 简 报

正弦平方势及退道过程的半经典描述·····	罗诗裕	刘曾荣	邵明珠	(82)
一种直接由 $C-t$ 参数确定未知掺杂样品产生寿命的方法·····	张秀淼			(86)
不同原子组成的长链固体的表面态·····	庞小峰	夏小林		(90)
InP (110) 表面电子能带计算 ·····	徐至中			(94)
新的 InP 位错腐蚀剂 ·····	王 兢	夏 平		(98)
半绝缘 GaAs 中的深能级 ·····	周炳林	陈正秀		(100)
一种汽相生长多层外延 InP 的方法·····	黄善祥			(104)
用离子束混合形成硅化钛·····	胡仁元			(107)